Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0307U001572

Державний реєстраційний номер: 0105U001880

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 04-04-2007

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Створення тонких плівок Hg1-xCdxTe, і CdTe на підкладках Si і GaAs.

Початок етапу: 01.2006

Закінчення етапу: 12.2006

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02125438

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (03-244) 3-33-32, 3-81-11

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00026777

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: www.mon.gov.ua

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка матеріалознавчої бази створення тонкоплівкових матеріалів для фотоперетворювачів видимої і інфрачервоної області спектру.

Назва роботи англійською:

Development of the raw material base for production of thin solid materials for infrared and visible radiation photorecevier.

Реферат українською:

Отримано результати по вирощуванню тонких плівок напівпровідникових сполук A2B6 - CdTe і HgCdTe, та гетероструктур на їх основі методом лазерної епітаксії. Розроблено технологію випаровування напівпровідникових матеріалів лазером YAG:Nd3+ з наступним їх осадженням на кристалічні та аморфні підкладки різної структури. Досліджено умови росту плівок на їх структурні та фотоелектричні властивості. Зокрема, це температура осадження і густина енергії імпульсів. Встановлена залежність параметрів кристалічної ґратки вирощених напівпровідникових плівок від технологічних режимів.

Реферат англійською:

Results are got on growing of thin films of semiconductor connections A2B6- CdTe and HgCdTe,and geterostructures on their basis by the method of laser epitaxy. Technology of evaporation of semiconductor materials is developed by a laser YAG:Nd3+ with a next their besieging on crystalline and amorphous substrates of a different structure. The terms of growth of films are explored on their structural and photoelectric properties. In particular, it is the temperature of besieging and density of energy of impulses. The set dependence of parameters of crystalline the lattice reared semiconductor films from the technological modes.

Індекс УДК: 53, 681.51

Коди тематичних рубрик: 29.01

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Вірт Ігор Степанович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1.Virt I.S., Bilyk I.S., Popovych V.D., Rudyj I.O.,Kurilo I.V., Kolek A., Bester M., Kuzma M. Photoelectrical and noise processes in CdTe crystals// Physica status solidi (c), V. 3, Iss. 4, 2006, P. 1055-1058. 2.Bylica A., Sagan P., Virt I., Wisz G., Bester M.,Stefaniuk I., Kuzma M. Layers of CdTe and CdS obtained by PLD on ITO substrates// Thin Solid Films, 2006,V. 511 - 512, P. 439 - 442

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Скотний Валерій Григовович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

